



# D882

TRANSISTOR (NPN)

简介:

NPN 型高频放大环境额定双极型晶体管，主要用于低压电源调整电路及一般高频放大电路。

特点: ★ D882 与 B722 互补。

产品标准: (1.10)

最大规格 (Ta=25°C) TO-126

参数	符号	规格	单位	<b>TO-126</b> 
集电极-基极电压	$V_{CBO}$	40	V	
集电极电流	$I_C$	3	A	
集电极功耗	$P_{CM}$	30	W	
结温	$T_j$	150	°C	

电特性 (Ta=25°C)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
集电极-基极击穿电压	$BV_{CBO}$	$I_C=0.05mA, I_E=0$	40			V
集电极-发射极击穿电压	$BV_{CEO}$	$I_C=0.1mA, I_B=0$	30			V
发射极-基极击穿电压	$BV_{EBO}$	$I_E=0.05mA, I_C=0$	6			V
集电极-基极截止电流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=30V, I_E=0$			10	$\mu A$
集电极-发射极截止电流	$I_{CEO}$	$V_{CE}=20V, I_B=0$			20	$\mu A$
发射极-基极截止电流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=3V, I_C=0$			10	$\mu A$
直流电流增益	hFE	$V_{CE}=2V, I_C=1A$	100		400	
		$V_{CE}=5V, I_C=1mA$	60			
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE(sat)}$	$I_C=2A, I_B=200mA$			0.5	V
基极-发射极饱和电压	$V_{BE(sat)}$	$I_C=2A, I_B=200mA$			2	V
特征频率	$f_T$	$V_{CE}=5V, I_C=0.1A, f=10\text{ MHz}$	50	80		MHz

HFE 分档范围: (允许测试误差 10% )

Range	200-300	300-400

### 特性曲线

